

广东省粤晶高科股份有限公司

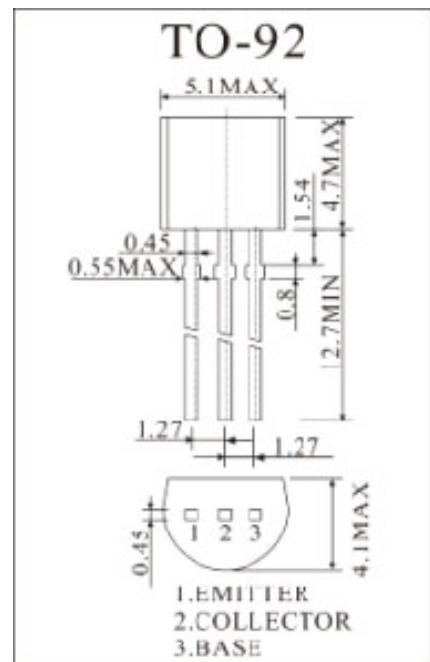
C1815

—NPN silicon—

■■主要用途：音频通用放大、中频放大。

■■绝对最大额定值 ( $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )

项 目	符 号	额 定 值	单 位
集电极—基极电压	$V_{\text{CBO}}$	60	V
集电极—发射极电压	$V_{\text{CEO}}$	50	V
发射极—基极电压	$V_{\text{EBO}}$	5	V
集电极电流	$I_c$	150	mA
集电极耗散功率	$P_c$	400	mW
结 温	$T_J$	150	$^{\circ}\text{C}$
存储温度	$T_{\text{stg}}$	- 55~150	$^{\circ}\text{C}$



■■电参数 ( $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )

项 目	符 号	最 小 值	典 型 值	最 大 值	单 位	测 试 条 件
直流电流增益	$h_{\text{FE}}$	70		700		$V_{\text{CE}}=6 \text{ V}, I_c=2 \text{ mA}$
集电极-基极截止电流	$I_{\text{CBO}}$			0.1	$\mu \text{A}$	$V_{\text{CB}}=60 \text{ V}, I_E=0$
发射极-基极截止电流	$I_{\text{EBO}}$			0.1	$\mu \text{A}$	$V_{\text{EB}}=5 \text{ V}, I_c=0$
集电极-基极击穿电压	$BV_{\text{CBO}}$	60			V	$I_c=0.02 \text{ mA}, I_E=0$
集电极-发射极击穿电压	$BV_{\text{CEO}}$	50			V	$I_c=1 \text{ mA}, I_B=0$
发射极-基极击穿电压	$BV_{\text{EBO}}$	5			V	$I_E=0.02 \text{ mA}, I_c=0$
集电极-发射极饱和压降	$V_{\text{CE}(\text{sat})}$		0.1	0.25	V	$I_c=100 \text{ mA}, I_B=10 \text{ mA}$
基极-发射极饱和压降	$V_{\text{BE}(\text{sat})}$			1	V	$I_c=100 \text{ mA}, I_B=10 \text{ mA}$
电流增益-带宽乘积	$f_t$	80			MHz	$I_c=1 \text{ mA}, V_{\text{CE}}=10 \text{ V}$
共基极输出电容	$C_{\text{ob}}$		2	3.5	PF	$V_{\text{CB}}=10 \text{ V}, I_E=0, f=1 \text{ MHz}$
噪声系数	$N_F$		1	10	dB	$V_{\text{CE}}=6 \text{ V}, I_c=0.1 \text{ mA}, f=1 \text{ KHz}, R_g=10 \text{ k}\Omega$

■■ $h_{\text{FE}}$  分档及其标志

分 档	O	Y	GR	BL
$h_{\text{FE}}$	70~140	120~240	200~400	350~700